

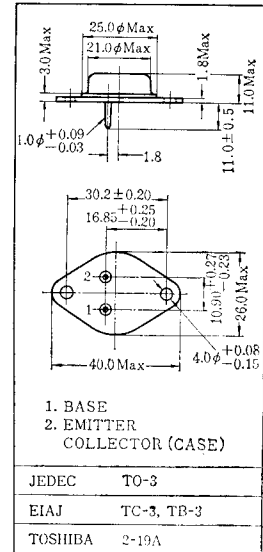
シリコンNPN拡散接合形トランジスタ
SILICON NPN DIFFUSED JUNCTION TRANSISTOR

2SD113, 2SD114

- 低周波大電力増幅用
- 大電力スイッチング用
- DC-DCコンバータ用
- 電源レギュレータ用
- Audio Power Amplifier Power Switching Application, DC-DC Converter and Regulator Applications.

通信工業用
Industrial Applications

Unit in mm



アクセサリはAC73を適用
MOUNTING KIT NO. AC73

- コレクタ損失が大きい: $P_C=200W$ ($T_C=25^\circ C$)
- コレクタ電流が大きい: $I_C=30A$
- 高耐圧です。: $V_{CBO}=100V$ (2SD113)
 $V_{CBO}=70V$ (2SD114)

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	I_C	30	A
エミッタ電流	I_E	-30	A
ベース電流	I_B	5	A
コレクタ損失	P_C	200	W
接合温度	T_J	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

Note 1; シリコン・グリースを塗布し、マイカ絶縁板を介して 300×300×2mm Al 放熱板を取付けたとき。
Unit mounted on a 300×300×2mm Al, heat sink with silicone greased mica insulator.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=50V, I_E=0$	—	—	2	mA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=10V, I_C=0$	—	—	50	mA
コレクタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10mA, I_E=0$	100	—	—	V
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50mA, R_{BE}=\infty$	80	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=50mA, I_C=0$	10	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note 2)	$V_{CE}=5V, I_C=1A$ (Note 3)	30	—	300	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5V, I_C=15A$ (Note 3)	10	12	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=15A, I_B=3A$ (Note 3)	—	0.8	1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=15A, I_B=3A$ (Note 3)	—	1.6	2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=1.0A$	—	1.5	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=50V, I_E=0, f=1MHz$	—	400	—	pF
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	—	3	—	μs
	蓄積時間	t_{stg}	—	5	—	μs
	下降時間	t_f	—	5	—	μs